Copyright © 2014 by Academic Publishing House Researcher



Published in the Russian Federation Nanotechnology Research and Practice Has been issued since 2014. ISSN: 2312-7856 Vol. 2, No. 2, pp. 68-72, 2014

DOI: 10.13187/ejnr.2014.2.68 www.ejournal13.com



UDC 535.301.2

Electronic Structure Of C₇₆ Fullerite

Elena L. Busygina

Kamsky Institute of Humanities and Engineering Technology, Russian Federation 12a, B. Sivkova str., Izhevsk, 426003 E-mail: bel28@rambler.ru

Abstract

Full sets of the fundamental optical functions of the fullerite C_{76} films were determined in the o-4o eV energy range. The calculations were performed from the experimental electron energy loss spectra. The results of calculations were compared with known theoretical dates. The dielectric function spectra were decomposed into elementary components. The main parameters of components were found (the energy values of the maxima, the relative area and half-widths of the band, and oscillator strengths).

Keywords: fullerite; film; electronic structure; integral specter; decomposition.

Введение

В последние годы, начиная с 1985 г., появилось много публикаций, посвященных исследованию таких углеродных структур как фуллерены, причем основная масса работ посвящена двум наиболее стабильным модификациям – C_{60} и C_{70} [1–3], а высшие фуллерены рассматриваются исследователями значительно реже [4]. Более низкой симметрией по сравнению с C_{70} обладает молекула фуллерена C_{76} . Ее поверхность состоит из 12 пятиугольников и 28 шестиугольников. Размеры молекулы C_{76} вдоль направлений ее осей симметрии составляют 0.879, 0.764 и 0.668 нм [5]. При комнатной температуре молекулы C_{76} образуют гранецентрированную кубическую решетку с постоянной решетки, равной 1.53±0.01 нм [6]. Электронная структура и фундаментальные оптические функции определяют физические свойства, а, следовательно, и принципиальные возможности прикладного применения конденсированного вещества. Поэтому принципиально важной задачей является нахождение полного комплекса оптических функций в наиболее широком энергетическом интервале на основе измеренных экспериментальных спектров.

Для пленок фуллерита С₇₆ известны две работы, где приводятся экспериментальные кривые функции объемных потерь энергии электронов -Im ε ⁻¹ в интервалах 0–35 [6] и 0–40 эВ [7]. Причем оба спектра дают интегральную кривую как сумму всех переходов. Из-за сильного перекрытия многие из них могут структурно не наблюдаться. Поэтому другой фундаментальной задачей спектроскопии является установление наиболее полного набора оптических переходов и их параметров: энергии максимума *E*, полуширины *H*, вероятности перехода *f*, относительной площади полос *S*/*S*_{макс}.

Результаты расчетов

В работе рассчитаны полные комплексы фундаментальных оптических функций поликристаллических пленок С₇₆, интегральные спектры диэлектрической проницаемости разложены на элементарные компоненты, для каждой из которых определены основные параметры (*E*, *H*, *f*, *S*/*S*_{макс}). Расчеты выполнены по известным методикам [8, 9] на основе двух имеющихся экспериментальных спектров объемных характеристических потерь энергии электронов [6, 7]. Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися теоретическими данными [10, 11]. В работе представлены только результаты разложений интегральных спектров ε_2 и ε_1 на отдельные вклады.

Для решения задачи разложения интегральных спектров ε_2 в работе был применен ранее многократно апробированный метод объединенных диаграмм Арганда [12–16], который позволяет без подгоночных параметров однозначно разложить кривую ε_2 на минимальный набор лоренцевских осцилляторов, а также определить их основные параметры. Результаты разложения полученных в работе спектров ε_2 пленок С₇₆ представлены в *таблице 1*.

Всего в интервале 0–40 эВ выявлено 15 полос вместо двух максимумов и трех ступеней интегральных кривых. Поскольку интегральные кривые мнимой части диэлектрической проницаемости двух пленок отличаются друг от друга и по расположению, и по интенсивности основных особенностей, то соответствующие различия наблюдаются также в количестве и расположении выделенных нами осцилляторов, причем положения максимумов определены с высокой точностью: ±0.01 для самых интенсивных и ±(0.01–0.04) эВ для остальных полос. Следует подчеркнуть, что в общепринятом приближении представления интегральной диэлектрической проницаемости как суммы вкладов отдельных лоренцевских осцилляторов метод диаграмм Арганда позволяет однозначно разложить интегральные спектры на минимальный набор полос, что обусловлено необходимостью одновременного учета спектров ε_1 и ε_2 . При этом в каждой полученной позволяет произвести дальнейшее разложение выделенных полос на компоненты.

Таблица 1.

В таблице приведены энергии максимумов *E*, эВ, силы осцилляторов *f*, полуширины *H*, эВ и относительные площади $S/S_{\text{макс}}$ полос спектров ε_2 пленок фуллерита C₇₆, рассчитанные на основе экспериментальных спектров -Im ε^{-1} работ [6] (1), [7] (2)

| Nº | E | | f | | Н | | $S/S_{ m makc}$ | |
|----|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2.11 | - | 1.57 | - | 0.71 | - | 0.08 | - |
| 2 | 2.77 | 2.88 | 1.29 | 0.74 | 0.79 | 0.51 | 0.19 | 0.04 |
| 3 | 3.30 | - | 0.20 | - | 0.58 | - | 0.05 | - |
| 4 | 4.23 | 4.35 | 1.75 | 2.82 | 1.85 | 2.18 | 0.85 | 1.00 |
| 5 | 5.08 | 5.24 | 0.31 | 0.42 | 0.97 | 1.41 | 0.20 | 0.23 |
| 6 | 5.81 | | 0.23 | | 1.45 | | 0.18 | |
| 7 | 10.37 | 9.92 | 0.67 | 0.23 | 3.04 | 1.54 | 0.56 | 0.15 |
| 8 | | 11.52 | | 0.13 | | 1.48 | | 0.10 |
| 9 | 12.65 | 12.80 | 0.36 | 0.79 | 2.31 | 3.71 | 0.39 | 0.70 |
| 10 | 15.19 | 15.36 | 0.77 | 0.56 | 4.67 | 3.84 | 1.00 | 0.67 |
| 11 | 17.73 | 18.88 | 0.13 | 0.42 | 2.64 | 5.48 | 0.20 | 0.62 |
| 12 | 20.47 | | 0.23 | | 3.96 | | 0.38 | |
| 13 | 23.77 | 22.08 | 0.24 | 0.14 | 6.60 | 3.84 | 0.41 | 0.21 |
| 14 | | 26.24 | | 0.07 | | 3.84 | | 0.10 |
| 15 | 30.38 | 30.08 | 0.15 | 0.09 | 9.24 | 6.40 | 0.24 | 0.13 |

Заключение

Теоретическое обсуждение конкретной природы установленных в работе групп переходов и их параметров для фуллерита C_{76} в области энергии 0–40 эВ затруднено из-за отсутствия соответствующих зонных расчетов электронной структуры молекул и кристаллов C_{76} . Но по аналогии с фуллеритами C_{60} и C_{70} заранее принимается, что для фуллерита C_{76} , по крайней мере, интенсивные полосы обусловлены экситонами малого радиуса типа френкелевских, обычно характерными для молекулярных кристаллов [9, 17]. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что из-за более низкой симметрии молекулы C_{76} происходит расщепление вырожденных в C_{60} и C_{70} занятых и свободных молекулярных термов, которое усугубляется различными возмущениями, имеющими место в реальных кристаллах. Поэтому зоны C_{76} могут иметь весьма сложное тонкое строение. Для детального количественного анализа установленных в работе переходов фуллерита C_{76} и их параметров необходимы соответствующие теоретические расчеты. С другой стороны, использование установленной в работе новой информации о наиболее полном наборе компонент переходов и их параметрах (*E*, *f*, *H*, *S*/*S*_{макс}) поможет разработать необходимые модели электронной структуры фуллерита C_{76} в широкой области энергии собственного поглощения (0–40 эВ).

Благодарности

Автор выражает благодарность Соболеву В.В. и Калугину А.И. за помощь в получении и обсуждении результатов.

Примечания:

1. Kataura H., Endo Y., Achiba Y., Kikuchi K., Hanyu T., Yamaguchi Sh. // Dielectric Constants of C_{60} and C_{70} Thin Films. Japanese Journal of Applied Physics. 1995. V. 34. Nº 10B. P. L1467–L1484.

2. Iwasa Y., Yasuda T., Naito Y., Koda T. // Optical Reflection Spectra of Fullerite Single Crystals. Activity Report of Synchrotron Radiation Laboratory. The Institute for Solid State Physics. Tokyo. 1992. P. 32–33.

3. Gensterblum G. // Electronic structure and elementary excitations of C_{60} fullerene end fullerite. Journal of Electron Spectroscopy and Related Fenomena. 1996. V. 81. P. 89–223.

4. Kikuchi K., Nakahara N., Wakabayashi T., Honda M., Matsumiya H., Moriwaki T., Suzuki S., Shiromaru H., Saito K., Yamauchi K., Ikemoto I., Achiba Y. // Isolation and identification of fullerene family: C_{76} , C_{78} , C_{82} , C_{84} , C_{90} and C_{96} . Chemical Physics Letters. 1992. V. 188. N^o 3, 4. P. 177–180.

5. Елецкий А.В., Смирнов В.М. // Фуллерены и структуры углерода. Успехи физических наук. 1995. Т. 165. № 9. С. 977–1009.

6. Armbruster G.F., Romberg H.A., Schweiss P., Adelmann P., Knupfer M., Fink J., Michel R.H., Rockenberger J., Hennrich F., Schreiber H., Kappes M.M. // Cristal and electronic structure of solid C_{76} . Zeitschrift für Physik B – Condensed Matter. 1994. V. 95. P. 469–474

7. Kusuo R., Terauchi M., Tanaka M., Saito Y., Achiba Y. // Electron-energy-loss spectroscopy study of C_{76} . Physical Review B. 1995. V. 51. № 16. P. 11018–11021.

8. Бусыгина Е.Л. Моделирование оптических свойств и электронной структуры фуллерита С₆₀. Ижевск: НОУ КИТ, 2010.

9. Соболев В.В., Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников. Киев: Наукова думка, 1988.

10. Harigaya K., Abe S. // Optical absorption spectra and geometric effects in higher fullerenes. Journal of Physics: Condensed Matter. 1996. V. 8. P. 8057–8066.

11. Saito S., Sawada S.I., Hamada N., Oshiyama A. // Electronic and geometric structures of fullerenes. Materials Science and Engineering. 1993. V. B19. P. 105–110.

12. Соболев В.В., Бусыгина Е.Л. // Электронная структура фуллерита С₆₀. Физика твердого тела. 1999. Т. 41. № 6. С. 1124–1125.

13. Соболев В.В., Бусыгина Е.Л. // Электронная структура пленок С₆₀. Журн. прикладной спектроскопии. 1999. Т. 66. № 2. С. 227–232.

14. Соболев В.В., Бусыгина Е.Л. // Оптические постоянные монокристалла фуллерита. Оптика и спектроскопия. 1999. Т. 86. № 3. С. 464–467.

15. Соболев В.В., Бусыгина Е.Л. // Электронная структура пленок С₆₀. Физика и техника полупроводников. 1999. Т. 33. № 1. С. 31–35.

16. Бусыгина Е.Л. // Оптические функции монокристалла и пленок фуллерита С₇₀. Новый университет. Серия «Технические науки». 2011. № 2. С. 8–17.

17. Jiang X., Gan Z. // Theory of the excitonic effect in solid C₆₀. Physical Review B. 1995. V. 52. Nº 19. P. 14254–14262.

References:

1. Kataura H., Endo Y., Achiba Y., Kikuchi K., Hanyu T., Yamaguchi Sh. // Dielectric Constants of C60 and C70 Thin Films. Japanese Journal of Applied Physics. 1995. V. 34. № 10B. P. L1467–L1484.

2. Iwasa Y., Yasuda T., Naito Y., Koda T. // Optical Reflection Spectra of Fullerite Single Crystals. Activity Report of Synchrotron Radiation Laboratory. The Institute for Solid State Physics. Tokyo. 1992. P. 32–33.

3. Gensterblum G. // Electronic structure and elementary excitations of C60 fullerene end fullerite. Journal of Electron Spectroscopy and Related Fenomena. 1996. V. 81. P. 89–223.

4. Kikuchi K., Nakahara N., Wakabayashi T., Honda M., Matsumiya H., Moriwaki T., Suzuki S., Shiromaru H., Saito K., Yamauchi K., Ikemoto I., Achiba Y. // Isolation and identification of fullerene family: C76, C78, C82, C84, C90 and C96. Chemical Physics Letters. 1992. V. 188. № 3, 4. P. 177–180.

5. Eletskii A.V., Smirnov V.M. // Fullereny i struktury ugleroda. Uspekhi fizicheskikh nauk. 1995. T. 165. № 9. C. 977–1009.

6. Armbruster G.F., Romberg H.A., Schweiss P., Adelmann P., Knupfer M., Fink J., Michel R.H., Rockenberger J., Hennrich F., Schreiber H., Kappes M.M. // Cristal and electronic structure of solid C76. Zeitschrift für Physik B – Condensed Matter. 1994. V. 95. P. 469–474

7. Kusuo R., Terauchi M., Tanaka M., Saito Y., Achiba Y. // Electron-energy-loss spectroscopy study of C76. Physical Review B. 1995. V. 51. № 16. P. 11018–11021.

8. Busygina E.L. Modelirovanie opticheskikh svoistv i elektronnoi struktury fullerita S60. Izhevsk: NOU KIT, 2010.

9. Sobolev V.V., Nemoshkalenko V.V. Metody vychislitel'noi fiziki v teorii tverdogo tela. Elektronnaya struktura poluprovodnikov. Kiev: Naukova dumka, 1988.

10. Harigaya K., Abe S. // Optical absorption spectra and geometric effects in higher fullerenes. Journal of Physics: Condensed Matter. 1996. V. 8. P. 8057–8066.

11. Saito S., Sawada S.I., Hamada N., Oshiyama A. // Electronic and geometric structures of fullerenes. Materials Science and Engineering. 1993. V. B19. P. 105–110.

12. Sobolev V.V., Busygina E.L. // Elektronnaya struktura fullerita S60. Fizika tverdogo tela. 1999. T. 41. № 6. S. 1124–1125.

13. Sobolev V.V., Busygina E.L. // Elektronnaya struktura plenok S60. Zhurn. prikladnoi spektroskopii. 1999. T. 66. № 2. S. 227–232.

14. Sobolev V.V., Busygina E.L. // Opticheskie postoyannye monokristalla fullerita. Optika i spektroskopiya. 1999. T. 86. № 3. S. 464–467.

15. Sobolev V.V., Busygina E.L. // Elektronnaya struktura plenok S60. Fizika i tekhnika poluprovodnikov. 1999. T. 33. № 1. S. 31–35.

16. Busygina E.L. // Opticheskie funktsii monokristalla i plenok fullerita S70. Novyi universitet. Seriya «Tekhnicheskie nauki». 2011. № 2. C. 8–17.

17. Jiang X., Gan Z. // Theory of the excitonic effect in solid C60. Physical Review B. 1995. V. 52. № 19. P. 14254–14262.

УДК 535.301.2

Электронная структура фуллерита С76

Елена Леонидовна Бусыгина

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, Российская Федерация 426003, Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 12a E-mail: bel28@rambler.ru

Аннотация. Рассчитаны полные комплексы фундаментальных оптических функций поликристаллических пленок фуллерита C_{76} в области энергий 0–40 эВ на основе известных спектров объемных характеристических потерь энергии электронов. Результаты расчетов сопоставлены с известными теоретическими данными. Интегральные спектры диэлектрической проницаемости разложены на элементарные компоненты. Определены основные параметры каждой компоненты (энергия максимума, относительная площадь и полуширина полосы, сила осциллятора).

Ключевые слова: фуллерит; пленка; электронная структура; интегральный спектр; разложение.